

SOT23 NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER DARLINGTON TRANSISTOR

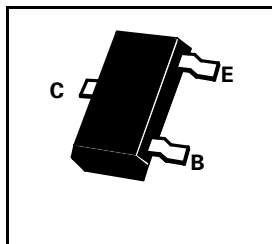
FMMT614

ISSUE 3 – APRIL 1996

FEATURES

- * h_{FE} up to 5k at $I_C = 500\text{mA}$
- * Fast switching
- * Low $V_{CE(sat)}$ at High I_C

PARTMARKING DETAILS – 614



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	120	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	100	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	10	V
Peak Pulse Current	I_{CM}	2	A
Continuous Collector Current	I_C	500	mA
Power Dissipation at $T_{amb}=25^\circ\text{C}$	P_{tot}	500	mW
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +150	$^\circ\text{C}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	120	300		V	$I_C=10\mu\text{A}, I_E=0$
Collector-Emitter Sustaining Voltage	$V_{CEO(sus)}$	100	130		V	$I_C=10\text{mA}, I_B=0^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	10	14		V	$I_E=10\mu\text{A}, I_C=0$
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}		0.02	10	nA	$V_{CB}=100\text{V}, I_E=0$
Collector Cut-Off Current	I_{CES}			10	μA	$V_{CES}=100\text{V}, I_E=0$
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}			100	nA	$V_{EB}=8\text{V}, I_C=0$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		0.9 0.78	1.0 0.9	V	$I_C=500\text{mA}, I_B=5\text{mA}^*$ $I_C=100\text{mA}, I_B=0.1\text{mA}$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		1.7	1.9	V	$I_C=500\text{mA}, I_B=5\text{mA}^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$		1.5	1.8	V	$I_C=500\text{mA}, V_{CE}=5\text{V}^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	15K 5K				$I_C=100\text{mA}, V_{CE}=5\text{V}^*$ $I_C=500\text{mA}, V_{CE}=5\text{V}^*$
Output Capacitance	C_{obo}		6		pF	$V_{CB}=10\text{V}, f=100\text{MHz}$
Switching Times	t_{on}		0.7		μs	$I_C=100\mu\text{A}, I_B=0.1\text{mA}$
	t_{off}		2.5		μs	$V_S=10\text{V}$

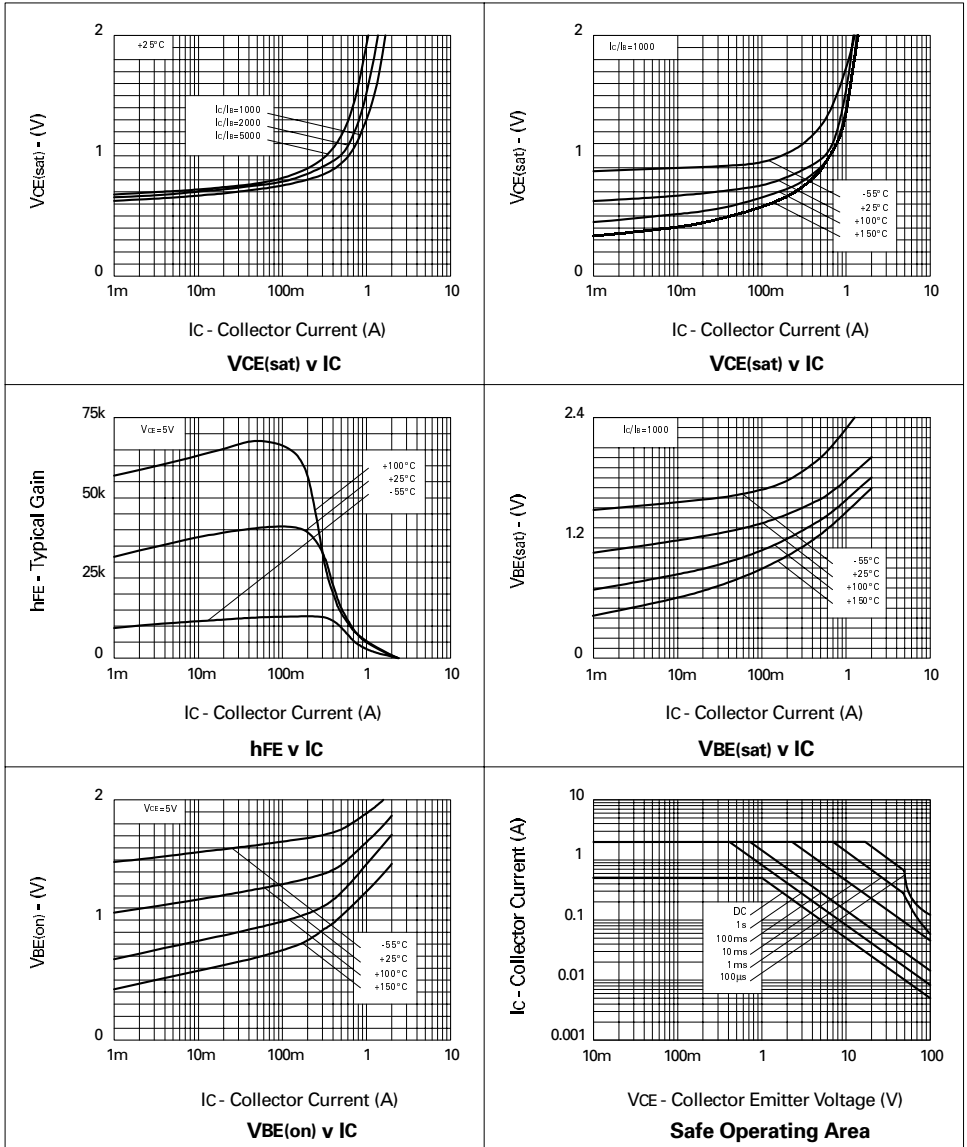
*Measured under pulsed conditions. Pulse Width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$

Spice parameter data is available upon request for this device

Typical Characteristics graphs are in preparation. Contact your local Sales office for more information.

FMMT614

TYPICAL CHARACTERISTICS



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9